

半 导 体 学 报

第 2 卷 第 4 期 1981 年 11 月

目 录

- 石墨夹层 LiC_6 的电子态 张开明 叶 令 (249)
- 用场效应方法研究 a-Si 中定域态密度 杨喜荣 廖显伯 孔光临 刘昌灵 (263)
- 用 X 射线形貌技术研究 GaAs 衬底及 $\text{GaAs-Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ DH 外延片中的缺陷 高维滨 石志文 任庆余 鞠静丽 (267)
- 液相外延 $\text{Ga}_{1-x}\text{Al}_x\text{As}$ 层中位错组态的透射电镜研究 梁静国 冯孙齐 潘桂明 陈焜兮 (273)
- CaAs 气相双层外延层中有源层与缓冲层过渡区宽度的研究 王永晨 (277)
- P 型硅 MOS 结构 $C(t)$ 不稳定性研究 马鑫荣 田立林 李志坚 (288)
- 用 MIS 结构 $C(t)$ 特性同时决定半导体表面层内及体内的少子寿命 马鑫荣 田立林 李志坚 (298)
- GaAs 高-低 IMPATT 二极管的掺杂分布和伏安特性分析 俞冠高 金立荣 张崇仁 (307)

研 究 简 报

- 确定 n-Si 补偿度的简捷方法 孙毅之 张又立 薛绍仁 徐维明 (317)
- 压力下隧道管的电流性质 王积方 (320)
- 突变 pin 结的解析解问题 阮英超 (324)

* * *

本刊改为双月刊启事

经上级批准,本刊自 1982 年起改为双月刊,欢迎广大撰稿人向本刊投稿。同时,本刊征稿简则较前有所改变,请注意参看本期刊登的征稿简则,今后将以修订的征稿简则为准。